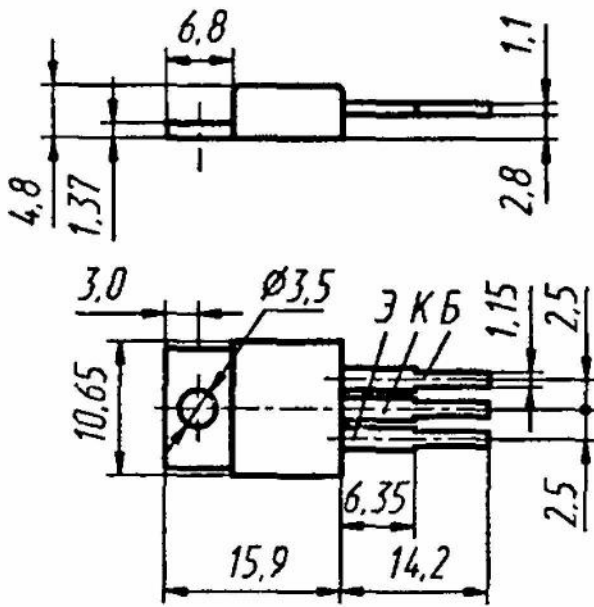


КТ712А, КТ712Б

КТ712(А,Б)



Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *p-n-p* составные усилительные. Предназначены для применения в источниках вторичного электропитания и стабилизаторах напряжения. Корпус пластмассовый с жесткими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 2,5 г.

Изготовитель — акционерное общество «Кремний», г. Брянск.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ} = 5$ В, $I_3 = 2$ А:

$T = +25$ °С:

КТ712А	500...1500... 10000
КТ712Б	400...1500... 10000

$T = +100$ °С:

КТ712А, не менее	500
КТ712Б, не менее	400

$T = -45$ °С:

КТ712А, не менее	100
КТ712Б, не менее	100

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ} = 5$ В, $I_3 = 0,5$ А,

не менее

3 МГц

Граничное напряжение при $I_к = 0,05$ А, не менее:

КТ712А	160 В
КТ712Б	150 В

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер

при $I_к = 2$ А, $I_б = 0,01$ А

0,9*...1,3*...2 В

Напряжение насыщения база—эмиттер

при $I_к = 2$ А, $I_б = 0,01$ А

0,8*...1,5*...3 В

Пробивное напряжение коллектор—база

при $U_{КБ} = 1$ мА, не менее:

КТ712А..... 200 В

КТ712Б..... 160 В

Обратный ток эмиттера при $U_{БЭ} = 5$ В,

не более..... 5 мА

типичное значение..... 2* мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база:

КТ712А..... 200 В

КТ712Б..... 160 В

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер

при $R_{БЭ} \leq 100$ Ом:

КТ712А..... 200 В

КТ712Б..... 160 В

Постоянное напряжение база—эмиттер..... 5 В

Постоянный ток коллектора..... 10 А

Импульсный ток коллектора при $t_{и} \leq 10$ мс,

$Q \geq 2$ 15 А

Постоянный ток базы..... 0,1 А

Импульсный ток базы при $t_{и} \leq 10$ мс, $Q \geq 2$ 0,2 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T = -45...+25$ °С:

с теплоотводом¹..... 50 Вт

без теплоотвода²..... 1,5 Вт

Температура р-п перехода..... +150 °С

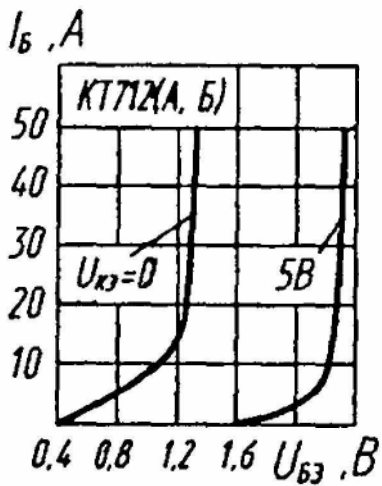
Температура окружающей среды..... -45... $T_K =$
= +100 °С

¹ При $T_K = +25...+100$ °С $P_{К, макс}$ уменьшается линейно до 20 Вт.

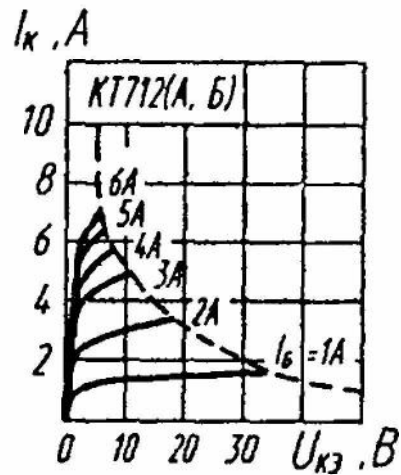
² При $T_K = +25...+100$ °С $P_{К, макс}$ уменьшается линейно до 0,6 Вт.

Допустимое значение статического потенциала 1000 В.

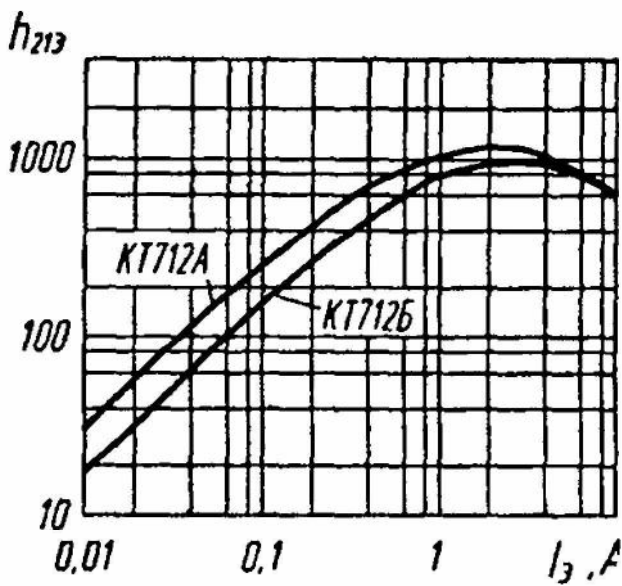
Пайка выводов транзисторов рекомендуется не ближе 5 мм от корпуса при температуре припоя +265 °С в течение не более 3 с. Допускается не более трех перепаек. Разрешается осуществлять пайку путем погружения выводов в припой с температурой +250 °С на время не более 5 с, допускается пайка волной припоя при температуре +240 °С.



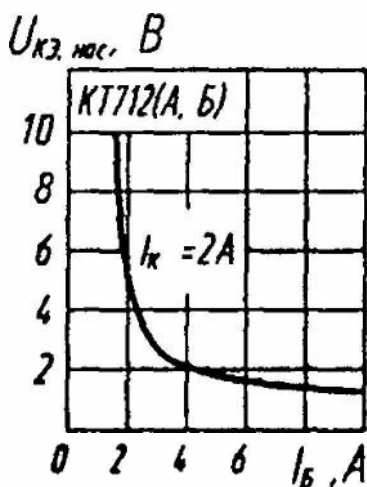
Входные характеристики



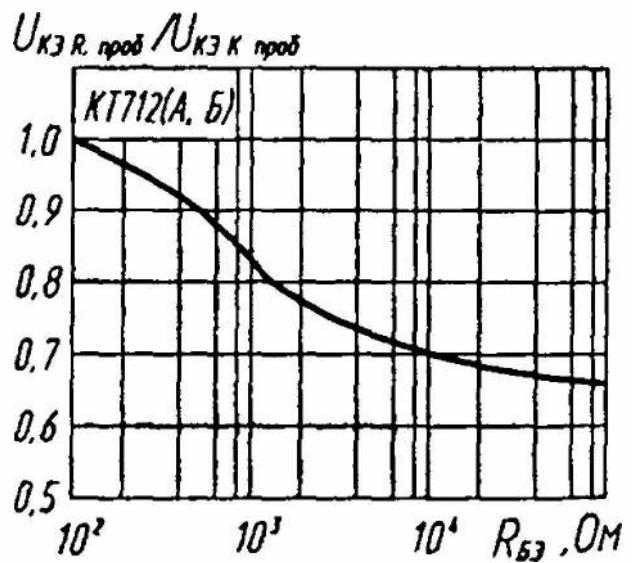
Выходные характеристики



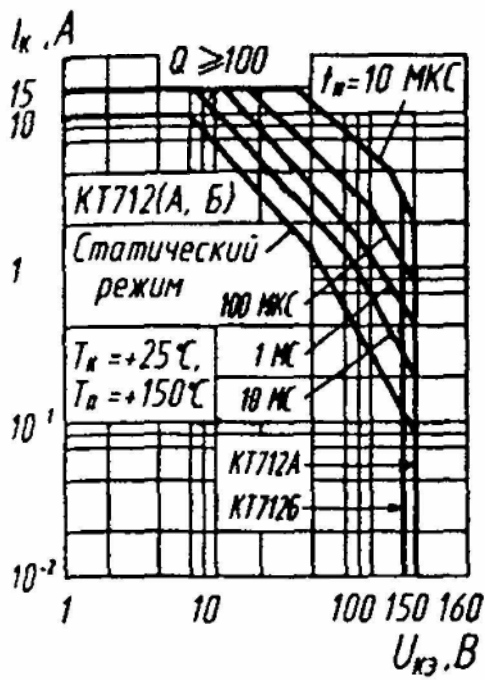
Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



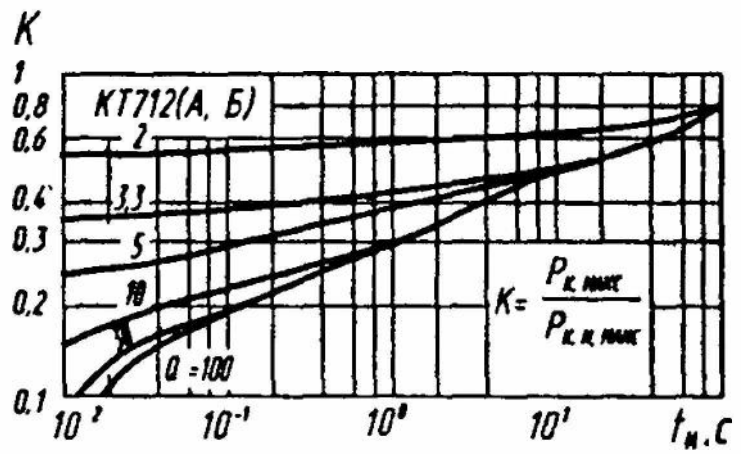
Зависимость напряжения насыщения коллектор—эмиттер от тока базы



Зависимость пробивного напряжения коллектор—эмиттер от сопротивления база—эмиттер



Области максимальных режимов



Зависимость коэффициента K от длительности импульса